

功能材料概论

南京航空航天大学

目 录

第一章 晶体学基础及材料性能	1
1.1 晶体特征	1
1.2 化学键与晶体	3
1.3 晶体结构	4
1.4 晶体缺陷	7
1.5 导体、半导体和绝缘体	8
1.6 功能材料的性能	10
第二章 高分子基础	13
2.1 高分子的概念	13
2.2 合成高分子的化学反应	16
2.3 高聚合物的分类和命名	18
2.4 高分子材料的特性	20
2.5 高聚物的溶解过程及溶液性质	22
第三章 超导材料	23
3.1 超导的微观图像	23
3.2 超导体的临界参数	26
3.3 低温超导材料	27
3.4 超导材料的应用	30
第四章 贮氢合金	33
4.1 金属贮氢原理	33
4.2 贮氢合金分类	36
4.3 贮氢合金的应用	41
第五章 形状记忆合金	45
5.1 形状记忆原理	45
5.2 形状记忆合金	49
5.3 形状记忆材料的应用	54
第六章 非晶态合金	57
6.1 非晶态合金的结构	57
6.2 非晶态材料的制备	59
6.3 非晶态合金	63
6.4 非晶态合金的性能及应用	64

第七章	磁性材料	70
7.1	软磁材料	70
7.2	硬磁材料	76
7.3	磁记录材料	82
第八章	半导体材料	88
8.1	典型半导体材料	88
8.2	半导体微结构材料	91
8.3	非晶态半导体	95
8.4	半导体陶瓷	98
第九章	光学材料	102
9.1	激光材料	102
9.2	光纤材料	105
9.3	红外材料	109
9.4	发光材料	110
9.5	光色材料	116
9.6	液晶材料	118
第十章	精细功能陶瓷	121
10.1	导电陶瓷	121
10.2	介电铁电陶瓷	122
10.3	气敏陶瓷和湿敏陶瓷	126
10.4	铁氧体	129
10.5	生物陶瓷	130
10.6	高温超导陶瓷	132
第十一章	功能转换材料	136
11.1	压电材料	136
11.2	热释电材料	138
11.3	光电材料	141
11.4	热电材料	143
11.5	电光材料	145
11.6	磁光材料	147
11.7	声光材料	150
第十二章	高分子试剂及固相合成	152
12.1	高分子试剂的特点	152
12.2	高分子氧化试剂	153
12.3	高分子还原试剂	157
12.4	氧化还原树脂	159
12.5	高分子转递试剂	164
12.6	高分子偶合剂	168

第一章 晶体学基础及材料性能

1.1 晶体特征

1.1.1 空间点阵

原子或分子结合成金属和陶瓷时,形成晶体。在晶体中,原子和原子集团在三维空间中有规律分布。如果将每一个可重复的单位用一个点来表示,就能形成一个有规则的三维点阵,称为空间点阵。图 1-1 表示了二维晶体结构和空间点阵示意图。为了便于分析各种晶体中原子排列的规律,空间点阵常用空间格子来表示,见图 1-2(a),这种空间格子称为晶格。由于晶格具有周期性,可取一单位体积(平行六面体)作为重复单元,来概括整个晶格的特征。这样选取的重复单元称为原胞,见图 1-2(b)。

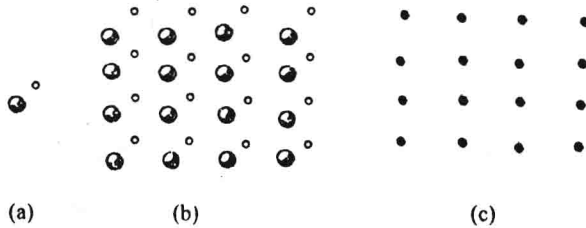


图 1-1 二维晶体结构和空间点阵示意图
(a)包含两种原子的结构单元 (b)晶体结构 (c)空间点阵

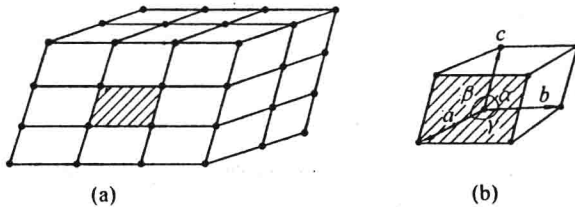


图 1-2 晶格和原胞

空间点阵就其对称性,可以分为十四种类型,(见图 1-3),隶属于七个晶系。

1.1.2 晶面指数

在晶体中,为了表达与晶轴相关的晶面方向或晶向,常使用三个整数,称为密勒指数。如图 1-4 所示,设有一晶面与 a, b, c 轴交于 M_1, M_2, M_3 三点,通过求出三个截距值倒数的最小整数比,即可得到该晶面的晶面指数(236)。图 1-5 中标出了晶体中一些晶面的密

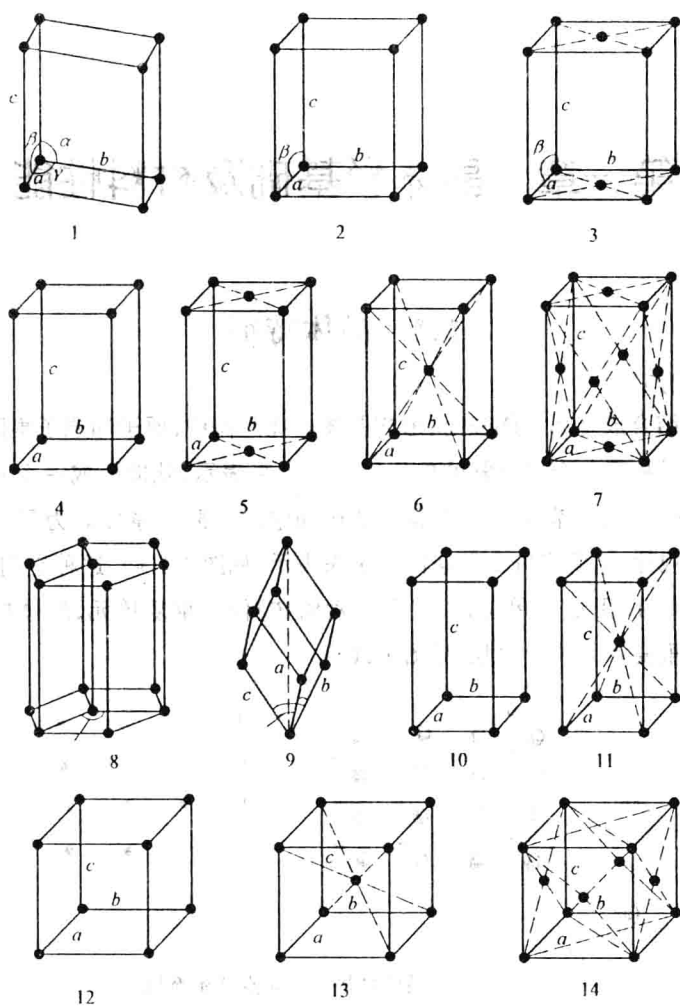


图 1-3 14 种布喇菲点阵的晶胞

- 1—简单三斜;2—简单单斜;3—底心单斜;4—简单正交;5—底心正交;
 6—体心正交;7—面心正交;8—简单六方;9—简单菱形;10—简单正方;
 11—体心正方;12—简单立方;13—体心立方;14—面心立方

勒指数。密勒指数简单的晶面,如(100)、(110),晶面上原子聚集密度较大,晶面之间的距离较大,结合力较弱,易分裂,这样的晶面为解理面。

1.1.3 对称性

晶体具有一定的对称性,晶体的对称性是指晶体经过某些对称操作后仍然能回复原状的特性。基本的对称操作为旋转与反映,对称操作所依赖的几何要素,如点、线、面,称为对称元素。

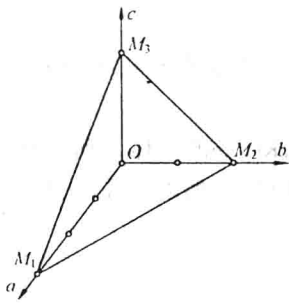


图 1-4 晶面指数

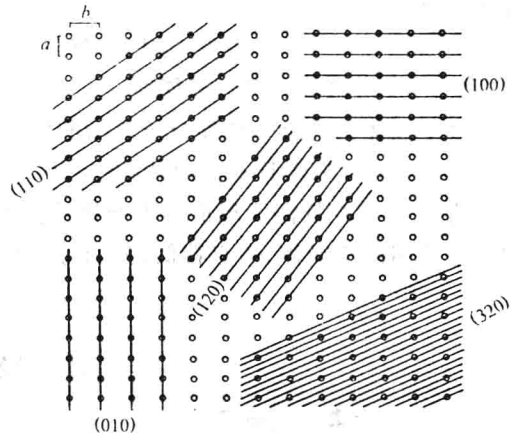


图 1-5 晶面指数与面间距

1.2 化学键与晶体

研究表明,当自由原子结合成晶体时,其最外层价电子的分布情况将要发生变化,并由此产生不同类型的结合力,晶体的结构和性质则主要决定于组成晶体的原子结构以及它们之间结合力的性质。

1.2.1 离子键与离子晶体

原子间最简单的作用力是离子键,它产生于正、负电荷之间的静电引力,典型的离子晶体是元素周期表中 I_A 族的碱金属元素 Li, Na, K, Rb, Cs 和 VII_A 族的卤族元素 F, Cl, Br, I 之间形成的化合物晶体。这种晶体是以正、负离子为结合单元的,最典型的结构有两种:一种是 NaCl 型结构,配位数为 6;另一种是 CsCl 型结构,配位数为 8。离子晶体结构稳定,结合能较大,具有导电性差、熔点高、硬度高和膨胀系数小等特点。大多数离子晶体对可见光是透明的,但在红外区域有一个特征吸收峰。

1.2.2 共价键与原子晶体

在晶体中,一对为两个原子所共有的自旋相反、配对的电子结构称为共价键。共价键有两个基本特点:饱和性和方向性。IV_B - VI_B 族元素是共价键结合,大多数共价键的最大数目符合 $8 - N$ 定则,其中 N 为原子的价电子数目,并且原子总是在其价电子波函数最大的方向上形成共价键。

元素周期表中第 IV_A 族元素 C(金刚石), Si, Ge, Sn(灰锡)的晶体是这类晶体的典型代表,它们的结构是金刚石结构。共价键结合是一种强的结合,晶体有很高的熔点和硬度,如金刚石是目前所知最硬的晶体,其熔点高达 3 550℃。同时,共价晶体中价电子定域在共价键上,因而其导电性很弱,一般属于绝缘体或半导体。

1.2.3 金属键与金属晶体

金属键的基本特征是电子为晶体共有,即原属于各原子的价电子不再束缚在原子上,可在整个晶体内运动(可视为离域的共价键),原子间结合较强。多数金属晶体以面心立

方排列,配位数为12。

金属具有良好的导电性、导热性及高延展性,其熔点较高。

1.2.3 范德华力与分子晶体

分子晶体的结合是依靠分子之间的作用力,这种作用力称为范德华力,其作用范围为0.2~0.5 nm,一般不具有方向性和饱和性。

惰性元素在低温下形成典型非极性分子晶体。Ne, Ar, Kr, Xe的晶体是面心立方结构。它们是透明的绝缘体,熔点特低,分别为24K, 84K, 117K和161K,温度升高时,易升华。

1.3 晶体结构

1.3.1 元素的晶体结构

如表1-1所示,元素的晶体结构可分三类。周期表左面的元素属于第一类。它们都是金属,具有面心立方、六方和体心立方等密堆积型的晶体结构,见图1-6。

表 1-2 元素的晶体结构*

I _A	II _A	III _B	IV _B	V _B	VI _B	VII _B	VIII			I _B	II _B	III _A	IV _A	V _A	VI _A	VII _A
Li b.	Be c.											B hex	C			
Na b.	Mg c.											Al f.	Si	P	S	Cl
K b.	Ca f.c.	Sc f.c.	Ti c.	V b.	Cr b.c.	Mn cub	Fe b.f.	Co c.f.	Ni f.c.	Cu f.	Zn hex	Ga orh	Ge	As	Se	Br
Rb b.	Sr f.	Y c.	Zr c.b.	Nb b.	Mo b.	Tc c.	Ru c.	Rh f.cub	Pd f.	Ag f.	Cd hex	In tet	Sn	Sb	Te	T
Cs b.	Ba b.	La c.f.	Hf c.	Ta b.	W b.cub	Re c.	Os c.	Ir f.	Pt f.	Au f.	Hg rho	Tl c.f.	Pb f.	Bi		
			Th f.			U orh										
第一类结构											第二类结构			第三类结构		

*表中: b.体心立方, c.六方密堆积, f.面心立方密堆积, cub立方, hex六方, orh正交, tet四方, rho三方

周期表右面的元素属于第三类结构,它们是非金属。由于形成共价键,这类结构的配位数不超过8,遵守8-N规则。图1-7(a)是碘的晶体结构,配位数为2,形成链状结构;图1-7(b)是Te的结构,配位数为3,形成层状结构;图1-7(c)是As的结构,配位数为4,形成三维伸展

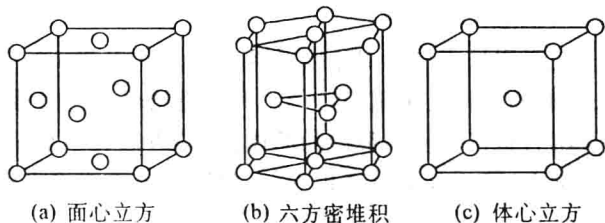


图 1-6 典型密堆积型的金属晶体结构

的网状结构。

处于周期表中间的一些少数元素属于第二类结构。它们之中锌和镉虽属六方结构,但不是密堆积。汞是简单三方结构,镓的结构复杂。具有六方密堆积的 α -Tl,具有面心立方的铅以及具有四方结构的铟,在结构上均相似于金属,但从原子间距上看,结构中却存在着原子部分分离。硼和锡结构介于第二类和第三类结构之间。

有些元素具有一种以上的结构形式,称其为同素异构体。一种元素是否有同素异构体,如果有,它的每种同素异构体在什么条件下生成,均取决于元素本身特性以外的温度、压力等外部条件。碳可以立方金刚石结构存在,也可以六方石墨结构存在。把石墨变成金刚石需 1 000℃ 以上的高温及巨大压强。铁的情形有所不同,具有体心立方的 α -Fe,在室温稳定存在,当温度升至 906 ~ 1 400℃ 之间,具有面心立方的 γ -Fe 取代了 α -Fe 成为主要晶型;当温度从 1 400℃ 升至熔点 1 535℃ 时,晶型又变回体心立方 δ -Fe。

1.3.2 典型晶体结构

氯化钠(NaCl)具有面心立方结构。每个结构单元含一个钠离子和一个氯离子,该结构可认为是分别由钠离子和氯离子组成的两个相同的面心立方格子,沿体对角线,相对位移 1/2 对角线长度,套构而成(图 1-8)。属于 NaCl 结构的一些有代表性的晶体见表 1-2。

表 1-2 具有氯化钠结构的晶体

晶体	a(nm)	晶体	a(nm)
LiH	0.408	AgBr	0.577
NaCl	0.563	MgO	0.422
KCl	0.629	MnO	0.443
PbS	0.592	kBr	0.659

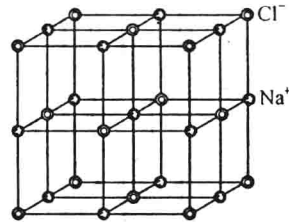


图 1-8 氯化钠晶体结构

氯化铯(CsCl)具有简单立方结构(图 1-9)。铯离子和氯离子分别组成两个相同的简单立方格子,沿体对角线相对位移 1/2 的长度套构而成。具有 CsCl 结构的一些晶体见表 1-3。

金刚石具有面心立方结构,每个结构单元包含两个原子。金刚石结构可认为是由两个相同的面心立方格子,沿体对角线相对位移 1/4 的长度套构而成(图 1-10)。

半导体锗和硅具有金刚石结构,这种结构空隙较大,杂质原子容易在这些材料中扩散,这一特性被应用到半导体器件的制作技术中。

如果把金刚石结构中的两个面心立方晶格上的碳原子,一个换成锌原子,另一个换成硫原子,则形成闪锌矿结构(图 1-11)。一些重要的化合物半导体材料,如砷化镓、锑化铟等晶体都具有闪锌矿结构,而且在[111]轴的上下两个方向上,表现出不同性质,其生长速

率和腐蚀速率不相同(图 1-12)。属于闪锌矿结构的晶体还有 CuF, CuCl, ZnSe, CdS, InAs, SiC 和 AlP。

表 1-3 具有氯化铯结构的晶体

晶体	a (nm)	晶体	a (nm)
CsCl	0.411	CuZn	0.294
TlBr	0.397	AgMg	0.328
TlI	0.420	LiHg	0.329
NH ₄ Cl	0.387	AlNi	0.288
CuPd	0.299	BeCu	0.270

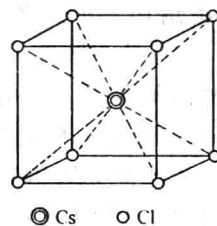


图 1-9 氯化铯晶体结构

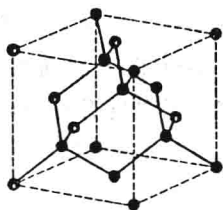


图 1-10 金刚石晶体结构

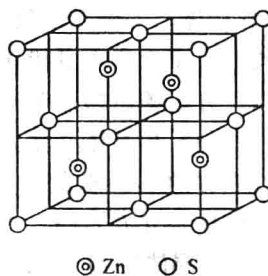


图 1-11 闪锌矿晶体结构

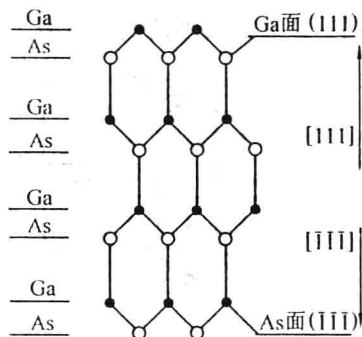


图 1-12 砷化镓晶体的
[111]和 $[\bar{1}\bar{1}\bar{1}]$ 晶向

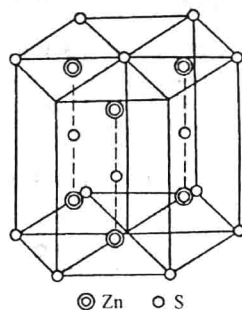


图 1-13 纤维锌矿晶体结构

纤维锌矿晶体结构属于六方晶系,晶格常数为 $a = 0.384 \text{ nm}$, $c = 0.5180 \text{ nm}$ 。在一个结晶学原胞中含有两个 Zn 原子、两个 S 原子,纤维锌矿晶体结构见图 1-13。

在纤维锌矿晶体结构中, S^{2-} 成六方最紧密堆积,而 Zn^{2+} 占有 $1/2$ 四面体空隙中,两种离子的配位数均为 4。属于纤维锌矿型结构的晶体有 CuBr, CuI, AgI, ZnO, CdS, CdSe, ZnSe, BN, GaN, AlN 等晶体。

萤石(CaF_2)晶体属于立方晶系,面心立方晶格,晶格常数 $a = 0.545 \text{ nm}$ 。在一个结晶

学原胞中含有 4 个 Ca 离子和 8 个 F 离子。整个萤石晶体结构可看作是三个相同的面立方点阵套叠而成,其结构见图 1-14。 Ca^{2+} 的配位数为 8, F^- 的配位数为 4。属于萤石结构的晶体有 BaF_2 , CdF_2 , ZrO_2 , CeO_2 等晶体。

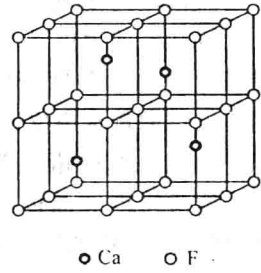


图 1-14 氟化钙晶体结构

钙钛矿 (CaTiO_3) 型结构是以天然钙钛矿命名的。在钙钛矿结构中, Ca^{2+} 和 O^{2-} 共同构成近似立方最紧密堆积, Ca^{2+} 周围有 12 个 O^{2-} , 每一个 O^{2-} 被 4 个 Ca^{2+} 包围, Ti^{4+} 占据着由 O^{2-} 形成的全部八面体空隙, CaTiO_3 晶体结构见图 1-15。

理想的钙钛矿型结构属立方晶系, 但许多属于这种结构的晶体却扭曲为正方、斜方或单斜晶系的晶体, 这种扭曲与晶体的压电、热释电和非线性光学性质有着密切的关系, 已成为一类十分重要的技术晶体。属于钙钛矿结构的晶体有 BaTiO_3 , PbTiO_3 等。

尖晶石 (AB_2O_4) 的结构见图 1-16。在尖晶石结构中, 能相互代替的三价元素有 Fe^{3+} , Al^{3+} , Cr^{3+} , Mn^{3+} , 二价元素有 Mg^{2+} , Fe^{2+} , Zn^{2+} , Mn^{2+} 。该晶体属立方晶体, 晶胞内含有 8 个分子。在天然矿物中有以下几种尖晶石型矿物: 锌尖晶石 ZnAl_2O_4 , 铁尖晶石 (FeAl_2O_4)、锰尖晶石 (MnAl_2O_4) 和镁铁尖晶石 [$\text{Fe}^{3+}(\text{MgFe}^{3+})\text{O}_4$] 等。

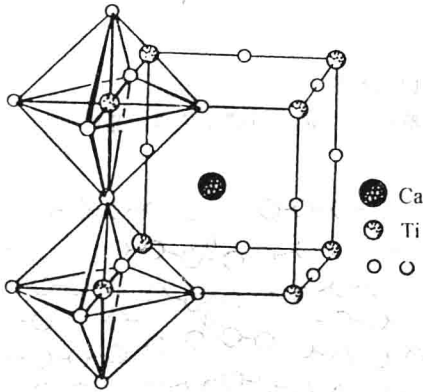


图 1-15 钙钛矿 (CaTiO_3) 晶体结构模型

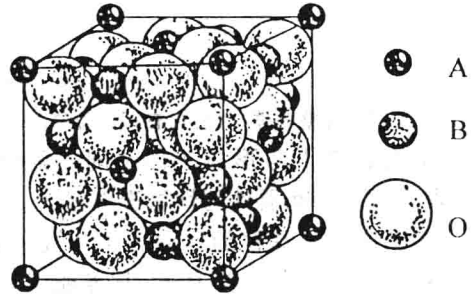


图 1-16 尖晶石的紧密堆积

1.4 晶体缺陷

实际晶体总是有各种缺陷, 功能材料的一些性能与这些缺陷密切相关。晶体缺陷按它们的几何形状分为点缺陷、线缺陷和面缺陷。

1.4.1 点缺陷

点缺陷在三维空间中各个方向上的尺寸都很小, 如空位、间隙原子、杂质原子等, 见图 1-17。半导体材料对杂质非常敏感, 其性能可以发生几个数量级的变化。

1.4.2 线缺陷

线缺陷即为位错。晶体中最简单的位错是刃型位错和螺型位错(图 1-18)。晶体中位错的量常用位错密度表示,单位体积中所包含的位错线总长度称为位错密度。位错密度对晶体的机械性能以及某些电学、磁学和光学性能都有显著影响。

1.4.3 面缺陷

主要的面缺陷是表面、界面和堆垛层错。表面层的原子既受到体内原子的束缚,又受环境影响,所以表面的组成和结

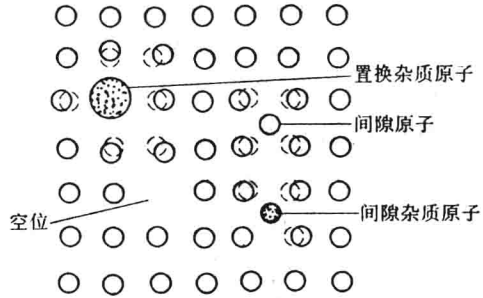


图 1-17 点缺陷示意图

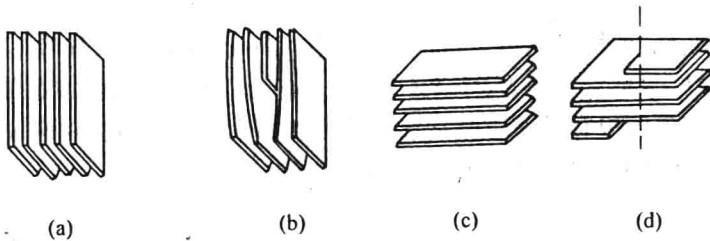


图 1-18 晶体中原子平面示意图

(a)完整晶体 (b)含有刃型位错的晶体 (c)完整晶体 (d)含有螺型位错的晶体

构在很大程度上与形成条件及随后的处理有关,表面对材料和器件的性能影响很大。

多晶体中各晶粒的取向各不相同,不同取向晶粒之间的接触面为晶界,晶界能阻止沿位错的运动。

堆垛层错出现于晶面堆积顺序发生错误的层面,将两个不正确堆垛层面隔开的就是堆垛层错(图 1-19),堆垛层错破坏了晶体的正常周期性,影响材料性能。

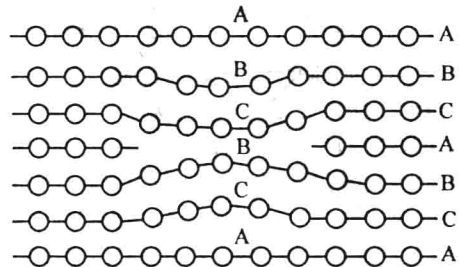


图 1-19 堆垛层错

1.5 导体、半导体和绝缘体

固体中含有大量的电子,但不同固体中的电子导电性相差很大,导体的电阻率在 $10^{-5} \sim 10^{-4} \Omega \cdot \text{cm}$,半导体的电阻率在 $10^{-4} \sim 10^{10} \Omega \cdot \text{cm}$,绝缘体的电阻率高达 $10^{10} \sim 10^{22} \Omega \cdot \text{cm}$ 。固体能带理论可以说明导体、半导体和绝缘体的区别。

1.5.1 能带填充与晶体导电性

当大量原子构成固体时,电子能级结构发生很大变化,能级会极端密集,形成能带。

对于 N 个原胞组成的晶体,简约布里渊区中可取 N 个不同的波矢 k ,标志单电子态,每个能带可容纳 $2N$ 个电子。 k 态电子以速度 $V(k) = \nabla_k E / \hbar$ 运动,并产生电流 $J = -eV(k)$ 。由于能带结构函数具有反演对称性, $E(k) = E(-k)$, $-k$ 态电子的速度与 k 态电子速度等值反号, $V(-k) = -V(k)$,所以 $-k$ 态电子产生的电流 $J(-k) = -eV(-k) = eV(k)$,恰好与 k 态电子产生的电流相抵消。

若一个能带被 $2N$ 个电子填满,则一切 k 与 $-k$ 态所产生的电流正好一一抵消,不会产生电流,并且电场并不改变满带中电子的分布。因此,可以得到满带中的电子不导电的结构。

若一个能带被电子部分填充, $T = 0K$,无外场时,电子填充至费米面,费米面内的态均有电子,这些态对 k 空间的原点是对称分布的。费米面内的 k 态与 $-k$ 态对电流的贡献一一相互抵消,不存在宏观电流。若存在外电场,由于电场的作用,电子在布里渊区中的分布不再是对称,总的电流不为零。若 $T > 0K$,情况大致与 $0K$ 相似,只是比费米能 E_F 高约 $k_B T$ 的态有一定的几率成为空态。因此,可以得到部分填充能带中的电子可以导电的结论。

1.5.2 导体、半导体和绝缘体的区别

由上面讨论可知,在电场的作用下,一个充满了电子的能带不可能产生电流,如果孤立原子的电子都形成满壳层,当有 N 个原子组成晶体时,能级过渡成能带,能带中的状态是能级中的状态数目的 N 倍,因此,原有的电子恰好充满能带中所有的状态,这些电子并不参与导电。相反,如果原来孤立原子的壳层并不满,如金属钠,一共有 11 个电子 ($1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$),当 N 个原子组成晶体时, $3s$ 能级过渡成能带,能带中有 $2N$ 个状态,可以容纳 $2N$ 个电子。但钠只有 N 个 $3s$ 电子,因此能带是半满的,在电场作用下,可以产生电流。周期表中第一族元素的价电子都处于未被充满的带中,它们都是金属,这种能带称为导带。碱土金属由于其 s 能带和较高的能带有交迭,价电子仍在不满的能带中参与导电,使其晶体具有金属的性质。

绝缘体的价电子把价带填满,上面的空带与价带之间存在一个较宽的禁带。在非强

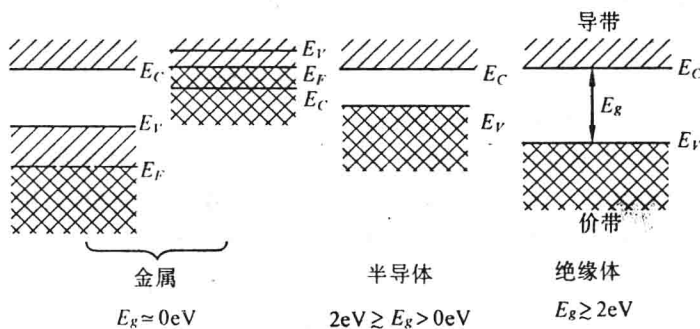


图 1-20 金属、半导体和绝缘体的能带结构

电场作用下不会产生电流(图 1-20)。

半导体的能带结构,与绝缘体的能带相似,只是禁带较窄。禁带宽度在 2eV 以下,通过热激发,把满带的电子激发到空带,而具有导电能力。由于热激发的电子数目随温度按指数规律变化,所以半导体的电导率随温度的变化也是呈指数的,这是半导体的主要特征。

1.6 功能材料的性能

1.6.1 半导体电性

根据能带理论,晶体中并非所有电子或价电子参与导电,只有导带中的电子或价带顶部的空穴才能参与导电。由于半导体禁带宽度小于 2eV ,在外界作用下(如热、光辐射),价带中留下空穴。这种空带中的电子导电和价带中的空穴导电同时存在的情况,称为本征电导。这类半导体称为本征半导体。

杂质对半导体的导电性能影响很大,例如在硅单晶中掺入十万分之一的硼原子,可使硅的导电能力增加一千倍,杂质半导体分为 n 型半导体和 p 型半导体,在四价的硅单晶中掺入五价的原子,成键后,多余一个电子,其能级离导带很近,易激发。这种多余电子的杂质能级称为施主能级。这类掺入施主杂质的半导体称为 n 型半导体。

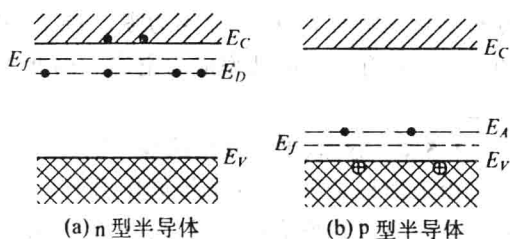


图 1-21 n 型与 p 型半导体能带结构

若在硅中掺入三价原子,成键后少一个电子,在距价带很近处,出现一个空穴能级(图 1-21)。这个空穴能级能容纳由价带激发上来的电子,这种杂质能级称为受主能级。受主杂质的半导体称为 p 型半导体。

n 型、p 型半导体的电导率与施主、受主杂质浓度有关。低温时,杂质起主要作用;高温时,属于本征电导性。

1.6.2 磁性

磁性是功能材料的一个重要性质,有些金属材料在外磁场作用下产生很强的磁化强度,外磁场除去后仍能保持相当大的永久磁性,这种特性叫铁磁性。过渡金属铁、钴、镍和某些稀土金属都具有铁磁性。铁磁性材料的磁化率可高达 10^6 。铁磁性材料所能达到的最大磁化强度叫饱和磁化强度,用 M_s 表示。

抗磁性是一种很弱、非永久性的磁性,只有在外磁场存在时才能维持,磁矩方向与外磁场相反。磁化率大约为 -10^{-5} 。如果磁矩的方向与外磁场方向相同,则为顺磁性,磁导率约为 $10^{-5} \sim 10^{-2}$ 。抗磁材料和顺磁材料都被看作是无磁性的。

在有些非铁磁性材料中,相邻原子或离子的磁矩作反方向平行排列,总磁矩为零,这种性质为反铁磁性。Mn, Cr, MnO 等都属反铁磁性材料。

亚铁磁性是某些陶瓷材料表现的永久磁性,其饱和磁化强度比铁磁性材料低。

任何铁磁体和亚铁磁体,在温度低于居里温度 T_c 时,都是由磁畴组成,磁畴是磁矩方

向相同的小区域,相邻磁畴之间的界叫畴壁。磁畴壁是一个有一定厚度的过渡层,在过渡层中磁矩方向逐渐改变。铁磁体和亚铁磁体在外磁场作用下磁化时, B 随 H 变化如图 1-22 所示。

1.6.3 超导性

1911 年荷兰物理学家昂尼斯发现汞的直流电阻在 4.2K 时,突然消失,他认为汞进入以零电阻为特征的“超导态”。通常把电阻突然变为零的温度称为超导转变温度,或临界温度,用 T_c 表示。

1933 年迈斯纳发现,超导体一旦进入超导态,体内的磁通量将全部被排出体外,磁感应强度恒等于零。这种现象称为迈斯纳效应,该效应展示了超导体与理想导体完全不同的磁性质。

所谓理想导体,其电导率 $\sigma = \infty$,由欧姆定律 $J = \sigma E$ 可知,其内部电场强度 E 必处处为零。由麦克斯韦方程 $\nabla \times E = \partial B / \partial t$ 可知,当 $E = 0$,则 $\partial B / \partial t = 0$,表明超导体内 B 由初始条件确定, $B = B_0$ 。但实验结果表明(见图 1-23),不论先降温后加磁场,还是先加磁场后降温,只要进入超导态(S 态),超导体就把全部磁通排出体外,与初始条件无关。

由此可知,电性质 $R = 0$,磁性质 $B = 0$ 是超导体两个最基本的特性,这两个性质既彼此独立又紧密相关。

1950 年美国科学家 E. M 麦克斯韦和 C. A. 雷诺兹分别独立发现汞的几种同位素临界温度各不相同, T_c 与原子质量的平方根成反比 $T_c \propto 1/M^\alpha (\alpha = 1/2)$,汞同位素的临界温度见表 1-4。

表 1-4 汞同位素的临界温度

汞原子质量 M	198	199.7	200.6	200.7	202.4	203.4
T_c / K	4.177	4.161	4.156	4.150	4.143	4.126

同位素原子量越小, T_c 越高,这种现象称为同位素效应。该效应为探明超导转变的微观机制提供了一条重要线索。

1.6.4 光谱性质

人们关于原子和分子的大部分认识是以光谱研究为依据,从电磁辐射和材料的相互作用产生的吸收光谱和发射光谱中,可以得到材料与其周围环境相互作用的信息。

吸收光谱是指物质在光谱范围里的吸收系数按光频率分布总体。一束光在通过物质

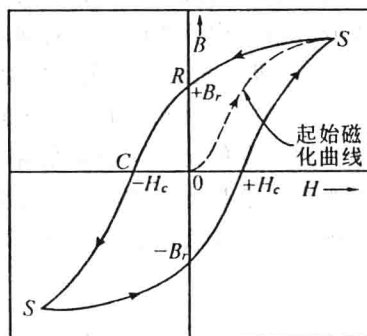


图 1-22 铁磁体和亚铁磁体的磁化曲线,退磁曲线和磁滞回线

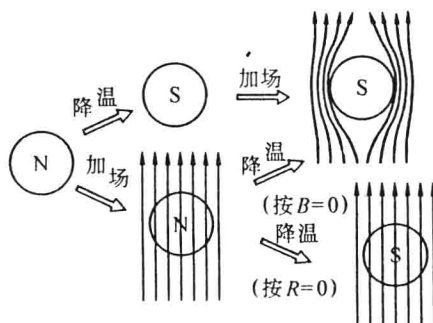


图 1-23 迈斯纳效应与理想导体情况比较

之后它的强度就发生减弱,有一部分能量被物质吸收。各种类型的发光物质表现出不同的吸收光谱。由于吸收光谱直接表征发光中心与它的组成、结构的关系以及环境对它的影响,所以吸收光谱对发光材料的研究具有重要的作用。

发光物质发射光子的能量按频率(或波长)分布的总体称为该物质的发射光谱,也称荧光光谱。发射光谱同吸收光谱一样,取决于发光中心的组成、结构和周围介质的影响。

激光光谱是指使物质产生发光时的激励光按频率分布的总体。通过激光光谱的测定可以确定有效吸收带的位置,即吸收光谱中哪些吸收带对产生某个荧光光谱带是有贡献的。

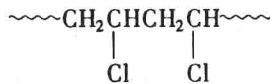
第二章 高分子基础

2.1 高分子的概念

2.1.1 高分子的含义

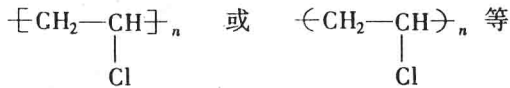
在我们的日常生活中,我们吃的粮食、肉类、蔬菜,穿的衣服,使用的塑料,橡胶制品的基本成分都是高分子化合物。

“高分子”这一名称,对应于英文的 Macromolecule, high polymer, polymer,相应的中文有高分子化合物、高分子物、高聚物、高分子、聚合物、大分子等多种说法,其含义也各有异同,目前尚未做统一的规定。这类物质的分子都是由成千上万个原子以共价键相互连接而成的,分子的尺寸很大,分子量一般在 $10^4 \sim 10^6$ 之间。尽管高分子的尺寸很大,分子量很高,但其化学组成往往比较简单,是由许多简单的结构单元多次重复连接组成的。如聚氯乙烯,是由许多氯乙烯结构单元重复连接而成的,表示为



上式中的 \sim 代表碳链骨架,表示还有很多 $\text{—CH}_2\text{—}\underset{\text{Cl}}{\text{CH}}\text{—}$ 这样的重复单元。以聚

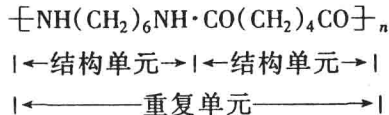
氯乙烯为例,高分子的结构还可以表示为



在以上的聚氯乙烯的结构式中,因为 n 值在一百以上,端基只占大分子中很少一部分,可以略去不计。括号内是聚氯乙烯的结构单元,也是其重复结构单元,并简称为重复单元。许多重复单元以共价键连接成线型大分子,类似一条链子,所以有时也称重复单元为链节。

能够形成结构单元的小分子化合物称为单体。单体是合成高聚物的原料。聚氯乙烯的结构单元与原料单体氯乙烯分子相比,除了电子结构有所改变外,原子的种类和各种原子的个数完全相同,这种单元又称为单体单元。

对于象聚氯乙烯一类的聚合物,其结构单元、重复单元、单体单元是相同的。还有另外一类聚合物,它的结构单元、重复单元是不同的,而且它的结构单元、重复单元与形成聚合物的原料单体也不相同。如尼龙-66。



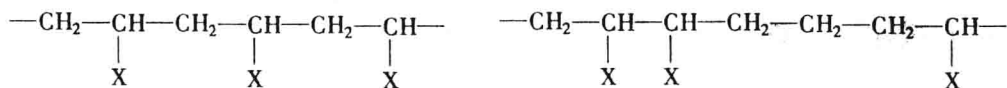
它的重复单元由 $\text{—NH(CH}_2)_6\text{NH—}$ 和 $\text{—CO(CH}_2)_4\text{CO—}$ 两种结构单元组成。而尼龙-66的单体是己二胺 $\text{NH}_2(\text{CH}_2)_6\text{NH}_2$ 和己二酸 $\text{HOOC(CH}_2)_4\text{COOH}$ 。重复单元要比单体少了一些原子,所以也不宜称做单体单元。

高聚物结构式中的方括号(或圆括号)表示重复连接的意思,而 n 代表重复单元数,称为聚合度,用 DP 表示。有些书刊中用结构单元数来表示聚合度,用 X_n 来表示。对于像聚氯乙烯这样的结构单元与重复单元相同的聚合物来讲, $\text{DP} = X_n$; 而对于象尼龙-66 这样的结构单元与重复单元不同的聚合物来说, $X_n = 2n = 2\text{DP}$ 。在应用时,要加以注意。总的来讲,聚合度是衡量高分子大小的一个指标。

2.1.2 高分子的结构

1. 高分子的化学结构

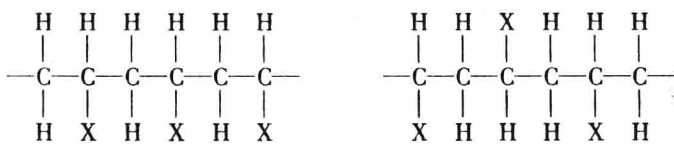
高聚物是由重复单元连接而成的,我们仔细分析像聚氯乙烯类的高聚物发现,它还存在着各种异构体。如以三个重复单元的连接方式表示,可有以下几种结构(X 表示取代基):



头尾结构

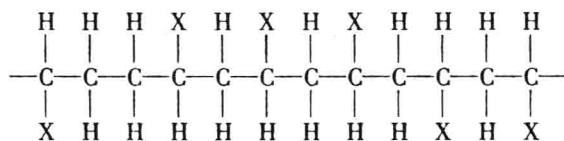
头头结构或尾尾结构

通常乙烯系聚合物是以头尾结构组成的。在这种情况下,它还存在着三种空间异构体,一种是取代基在同侧连接的全同(等规)立构体,一种是取代基交替在两侧连接的间同(间规)立构体。还有一种是取代基在两侧连接是无规的立构体。



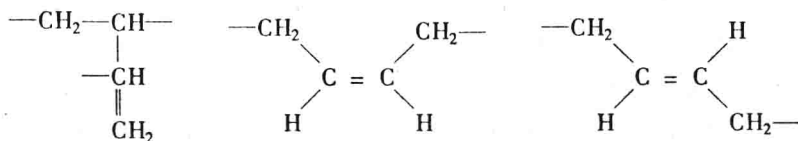
全同立构

间同立构



无规立构

双烯系高聚物,例如聚丁二烯,存在如下异构体。



1,2-结构

顺式 1,4-结构

反式 1,4-结构

而在 1,2-结构中,又有 1,2-全同立构,1,2-间同立构,1,2-无规立构几种异构体。而在聚丁二烯中,往往以上几种结构单元是同时存在的。由于所含结构单元的比例不同,高聚物的性质也显著的不同。